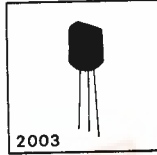


# 2SA1017 2SC2363

低周波電力増幅  
40 - 50W出力  
フリドライバ用



PNP/NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor

For Predriver of 40 to 50 W AF Amplifier

- ★A complementary pair.
- ★( ) shows 2SA1017 only.
- ★For the details, see 2SC2363 section.

⊖ C511B

( )内は 2SA1017の場合を示す.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-) 120	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-) 100	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	(-) 5	V
コレクタ電流	$I_C$	(-) 50	mA
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$	(-) 100	mA
コレクタ損失	$P_C$	500	mW
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55~+125	$^\circ\text{C}$

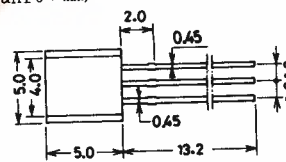
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
コレクタしゅ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = (-) 80\text{V}, I_E = 0$		(-) 1.0		$\mu\text{A}$
エミッタしゅ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = (-) 4\text{V}, I_C = 0$		(-) 1.0		$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE} = (-) 6\text{V}, I_C = (-) 1\text{mA}$	100*		560*	
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = (-) 6\text{V}, I_C = (-) 1\text{mA}$		(110) 130		MHz MHz
出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = (-) 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$	(1.0) 1.0	(2.2) 1.8	(3.0) 2.5	pF pF
C-E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = (-) 10\text{mA}, I_E = (-) 1\text{mA}$		(-) 0.5		V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = (-) 10\mu\text{A}, I_E = 0$	(-) 120			V
C-E 降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = (-) 1\text{mA}, I_E = \infty$	(-) 100			V
E-B 降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = (-) 10\mu\text{A}, I_C = 0$	(-) 5			V

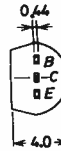
\* 2SA1017, 2SC2363は 1mA  $h_{FE}$  によりつぎのように分類している.

100	E	200	160	F	320	280	G	560
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2003  
(unit: mm)



JEDEC: TO-92  
EIAJ: SC-43  
SANYO: NP



B. Base  
C. Collector  
E. Emitter